H 对 Mg_2Si 力学性能影响的第一性原理研究^{*}

付正鸿 李婷 单美乐 郭糠 苟国庆†

(西南交通大学,先进材料教育部重点实验室,成都 610031)(2019年3月4日收到;2019年6月15日收到修改稿)

Al-Mg-Si 系铝合金在氢环境服役时,因遭受氢损伤而导致力学性能退化. Mg₂Si 是 Al-Mg-Si 系铝合金主要的热处理强化相,其力学性能直接决定着 Al-Mg-Si 系铝合金的强度.本文采用基于密度泛函数理论的第一性原理计算方法,研究了间隙 H 原子对 Mg₂Si 力学性能的影响.首先计算了 Mg₂Si 的单晶体弹性常数 C₁₁, C₁₂和 C₄₄,在通过 Hill 模型计算了多晶体的弹性模量、泊松比及硬度,并进一步计算了 H 对 Mg₂Si 晶粒拉伸性能的影响,最后对 H 原子掺杂引起的 Mg₂Si 晶体态密度变化进行了分析.结果表明: H 原子的引入显著降低 Mg₂Si 晶体的剪切模量和弹性模量,从而使得体系强度、硬度降低,韧性提高.拉伸性能计算也表明 H 原子 引起 Mg₂Si 晶体的剪切模量和弹性模量,从而使得体系强度、硬度降低,韧性提高.拉伸性能计算也表明 H 原子 引起 Mg₂Si 晶体断裂强度降低、断裂延伸率提高.态密度分析表明,Mg₂Si 晶体中引入氢原子,将引起 Mg₂Si 晶体由半导体性质向金属性质的转变,从而造成体系强度、硬度的降低,韧性增加.本文计算结果可以 为揭示以 Mg₂Si 为增强相的材料在氢环境中强度降低机理提供参考依据.

关键词:第一性原理, Mg₂Si, 弹性性质, 态密度 **PACS:** 71.20.-b, 71.22.+i, 43.35.Cg, 31.15.E-

DOI: 10.7498/aps.68.20190368

1 引 言

Mg₂Si 金属间化合物是 Al-Mg-Si 系铝合金主 要的热处理强化相,高弹性模量、高硬度的 Mg₂Si 颗粒弥散分布于铝合金基体中,通过阻碍位 错运动在 Al-Mg-Si 系铝合金形成弥散强化作用, 使铝合金强度硬度大幅度提高^[1,2].由于 Mg₂Si 的 高熔点 (1085 ℃)^[3],被用于替代 SiC 陶瓷制备铝基 复合材料,且具有良好的切削加工性和成形性.因 此, Mg₂Si 金属间化合物的研究备受关注^[4].

对于 Mg₂Si 金属间化合物的理论研究, 主要采 用基于密度泛函数理论的第一性原理计算方法. 任 玉艳等^[5] 对 Mg₂Si 金属间化合物的结构稳定性、 热力学和力学性能进行了系统的第一性原理计算 研究, 理论计算值与实验值十分接近. 余本海等^[6] 采用第一性原理的方法对 Mg₂Si 的同质异相体的晶体结构、电子结构及弹性性质进行了全面研究.

氢由于其原子半径极小,容易在材料中扩散, 并引起材料性能的变化.氢原子对晶体结构和力学 性质影响的第一性原理计算已经成为目前研究的 热点.韩秀丽等^[7]采用第一性原理的方法对 Ti-H 体系的晶体结构和能量进行了研究,氢原子的加入 引起 Ti 晶体的晶格畸变,降低了晶体的结合能. 氢在 α-Fe 和 γ-Fe 中掺杂均使晶体结构产生不同 程度的畸变,并降低了材料的塑性^[8,9].姚宝殿等^[10] 的研究显示氢对 Ti₃SiC₂ 的力学性质影响不大.对 α-Ti—H 键重叠集居数的研究发现^[11],氢减弱了 近邻原子间的成键强度,存在弱键效应;而在 β-Ti—H 中,氢增加了近邻钛原子间的键重叠集居 数,存在强键效应.氢的加入也会使 Nb 晶体发生 类似的电子结构变化^[12].α-Fe₂O₃—H 中, H 和

^{*} 西南交通大学博士创新基金 (批准号: D-CX201831) 和国家重点研发计划 (批准号: 2016YFB1200602-16) 资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: gouguoqing1001@163.com

^{© 2019} 中国物理学会 Chinese Physical Society

O之间成键,费米面附近出现了新的杂化能级,价带顶变宽,同时带隙由于导带底下移而减小,表明 氢可以用来调节能带结构^[13].

本文采用基于密度泛函数理论的第一性原理 方法,构建 Mg₂Si-H 体系,研究了氢原子浓度变化 对 Mg₂Si 金属间化合物弹性性质的影响,并对其力 学性能的变化进行了深入分析.

2 计算方法

Mg₂Si 金属间化合物具有反萤石结构, 空间群 号为 *Fm*3*m* (No. 255), 为面心立方 (FCC) 结构, 晶格常数 a = b = c = 0.676 nm, $\alpha = \beta = \gamma =$ 90°^[14]. Si 原子占据顶角和面心位置, Mg 原子位 于 Si 原子组成的四面体间隙中形成边长为 0.5*a* 的 简单立方结构, 余留体心位置的八面体间隙, 成为 H 等小半径原子优先固溶位置.

本文采用基于密度泛函数理论 (DFT) 和平面 波赝势的 CASTEP(Cambridge sequential total energy package)模块,对不同 H 原子浓度的 Mg₂Si-H 体系进行模拟计算.首先构建 Mg₂Si 晶 胞,几何优化后构建 $1 \times 1 \times 1, 1 \times 1 \times 2, 1 \times 2 \times 2$ 的 Mg₂Si 超晶胞,在体心八面体间隙中掺杂 H 原 子,形成 H 原子掺杂浓度分别为 7.69 at.%,4 at.% 和 2.05 at.% 的 Mg₂Si-H 体系,如图 1 所示.对掺 杂 H 原子后的超晶胞再进行几何优化,得到稳定 的 Mg₂Si-H 体系,然后对 Mg₂Si-H 体系进行弹性 性质计算.为更直观地反映 H 原子掺杂对 Mg₂Si 力学性的影响,分别计算了 $1 \times 1 \times 2$ 的 Mg₂Si 超晶胞和 $1 \times 1 \times 2$ 的 Mg₂Si-H (4 at.%) 超晶胞沿 [001] 方向进行拉伸的应力-应变曲线.拉 伸应变通过改变晶胞 [001] 方向的尺寸进行施加, 几何优化后获得对应的应力值.

计算过程采用周期性边界条件,结构优化和弹性性质计算过程中,采用广义梯度近似 (genaral gradient approximation, GGA) 中的质子平衡方程 (proton balance equation, PEB) 来处理电子间的交互关联能,势函数选用倒异空间中表述的超软 赝势 (ultrasoft pseudopotential). 计算中平面波截断能量 (cut off energy)取 400 eV,最大内应力为 1×10^{-3} GPa,原子最大位移为 2×10^{-4} nm,能量收敛标准为 1×10^{-6} eV/atom.第一布里渊区 k-point





177102-2

矢量分别取 $9 \times 9 \times 9$, $9 \times 9 \times 4$ 和 $9 \times 4 \times 4$.

在三向应力下, 材料共有 36 个弹性常数 C_{ij} (*i* = 1—6, *j* = 1—6). Mg₂Si 晶体为立方结构, 因此存 在三个独立的弹性常数, 即 C_{11} , C_{12} 和 C_{44} , 分别 体现体系在 [100], [111] 和 [011] 三个方向的抗变 形能力. 当 C_{11} , C_{12} 和 C_{44} 同时满足 C_{11} — $C_{12} > 0$, $C_{11} > 0$, $C_{44} > 0$ 和 $C_{11}+2C_{12} > 0$ 四个条件时, 合金体系才可以稳定存在, 满足力学性能稳定性条 件^[15]. 立方晶系剪切模量 C可由 C_{11} 和 C_{12} 计算:

$$C' = \frac{C_{11} - C_{12}}{2}.$$
 (1)

材料的力学性质在微观上可以通过弹性常数、 体模量、杨氏模量、剪切模量、泊松比和体模量/剪 切模量之比等体现. 多晶弹性模量通常可由单晶弹 性常数计算获得,计算方法可用 Voigt 模型和 Reuss 模型描述. 经验证, Voigt 模型和 Reuss 模型 所得模量通常为多晶模量的上限和下限,因此 Hill^[16,17] 对两者进行数学平均,发现所得值与实测 值一致性更好. 因此,实际应用中 Hill 模型更为常 用. 因此本文中 Mg₂Si 体模量 *B*_H,剪切模量 *G*_H 和 杨氏模量 *E* 的计算如下:

$$B_{\rm V} = B_{\rm R} = \frac{1}{3} \left(C_{11} + 2C_{12} \right),$$
 (2)

$$G_{\rm V} = \frac{1}{5} \left(C_{11} - C_{12} + C_{44} \right), \tag{3}$$

$$G_{\rm R} = \frac{5C_{44} \left(C_{11} - C_{12}\right)}{4C_{44} + 3 \left(C_{11} - C_{12}\right)},\tag{4}$$

其中 B_V 和 G_V 分别为 Voigt 模型的体积模量和剪 切模量, B_R 和 G_R 分别为 Reuss 模型的体积模量 和剪切模量. Hill 模型中体积模量 B和剪切模量 G分别为:

$$B_{\rm H} = \frac{B_{\rm V} + B_{\rm R}}{2},\tag{5}$$

$$G_{\rm H} = \frac{G_{\rm V} + G_{\rm R}}{2}.\tag{6}$$

杨氏模量 E 和泊松比 v 可由 B 和 G 计算得到^[18,19]:

$$E = \frac{9B_{\rm H}G_{\rm H}}{3B_{\rm H} + G_{\rm H}},\tag{7}$$

$$\nu = \frac{3B_{\rm H} - 2G_{\rm H}}{2\left(3B_{\rm H} + G_{\rm H}\right)}.$$
(8)

通常情况下, *B*反映材料抗体积压缩能力; *G*反映材料抗剪切应变的能力, 且与硬度相关^[19]; *E*反映材料抗正应变的能力, 也反映材料的硬度, *E*越大, 材料的硬度越高^[20]. 剪切应力下, *v*越小则 稳定性越好. *B*与*G*的比值是材料工程应用中必 须考虑的重要参数, 能反映材料的脆韧性, 以 1.75 作为临界值. 当 *B*/*G* > 1.75 时材料呈韧性, 否则呈脆性^[20,21].

材料的硬度与剪切模量、体模量之间存在直接 的对应关系^[22,23]. Miao 等^[24] 在通过第一性原理研 究材料的力学性质中,提出了硬度 *H* 与杨氏模量 *E* 和泊松比 *v* 之间计算的经验公式:

$$H = \frac{(1-2\nu)E}{6(1+\nu)}.$$
 (9)

3 计算结果与分析

3.1 晶体弹性常数

Mg₂Si-H体系晶体弹性常数 C_{11} , C_{12} , C_{44} 和 C'计算结果如表 1 所列. 从表 1 中可以看出, 所有 体系中 C_{11} , C_{12} 和 C_{44} 均同时满足 $C_{11}-C_{12} > 0$, $C_{11} > 0$, $C_{44} > 0$ 和 $C_{11}+2C_{12} > 0$ 四个条件, 说 明本文所建立的 Mg₂Si-H体系可以稳定存在, 满

表 1	Mg ₂ Si-H 体系晶体弹常数计算结果
Table 1.	Elastic constant of Mg ₂ Si-H system

Phase	Source	Elastic constants/GPa					
		C_{11}	C_{12}	C_{44}	C	$C_{12} - C_{44}$	
${ m Mg_2Si}$	This work	113.2	22.2	45.2	45.5	-23.0	
	Calculated $^{[20]}$	113.7	22.8	43.5			
	Calculated ^[6]	114.5	21.5	45.6			
	Experimental ^[21]	126.0	26.0	48.5			
$\rm Mg_2Si\text{-}2.05$ at.%H	This work	110.3	25.1	38.8	42.6	-13.7	
Mg_2Si-4 at.%H	This work	109.0	26.1	37.8	41.4	-11.7	
$\mathrm{Mg_2Si}\text{-}7.69 \mathrm{~at.\%H}$	This work	90.6	35.5	34.9	27.5	0.6	

足力学性能稳定性条件^[15].本工作中的 Mg₂Si 的 弹性常数 C₁₁, C₁₂ 和 C₄₄ 计算值分别为 113.2, 22.2 和 45.2 GPa,与其他学者的理论计算结果^[6,20] 相 比,最大计算误差分别为 1.15%, 2.70% 和 0.88%, 计算精度较高;与其他学者的试验结果^[21] 相比,本 工作中的, C₁₂ 和 C₄₄ 的最大计算误差分别为 10.16%, 14.61 和 6.80%,说明本文计算方法具有 较高的可靠性.

图 2 给出了弹性常数 C₁₁, C₁₂, C₄₄ 和 C'随氢 原子浓度增加的变化趋势. C11 值反映了体系在 [100] 方向的抗变形能力. 从图 2 中可以看出, 随氢 原子浓度从 0 增加到 7.69 at.% 过程中, C₁₁ 从 113.2 GPa 逐步减小到 90.6 GPa, 降低了 20%, 说 明H原子的引入显著降低了 Mg2Si 在 [100] 方向 抵抗变形的能力. C12 反映了体系 [111] 方向的抗 变形能力.从图 2 中可看出, H 原子浓度从 0 增加 到 7.69 at.% 过程中, Mg₂Si 的 C₁₂ 值从 22.2 GPa 增加到 35.5 GPa, 增加了 59.9%, 说明氢原子的引 入使得 Mg₂Si 抵抗 [111] 方向的抗变形能力明显提 高. C₄₄反映了体系 [011] 方向的抗变形能力, 随 H原子浓度从 0 增加到 7.69 at.%, Mg₂Si的 C44 从 45.2 MPa 降低到 34.9 GPa, 降低了 22.8%, 说明 Mg₂Si 在 [011] 方向抗变形能力随氢原子浓度 的增加而有所降低. 经(1)式计算得到的单晶体剪 切模量 C'则随着氢浓度从 0 增加到 7.69 at.%, 从 45.5 GPa降低到 27.5 GPa,降低了 39.5%,说明 H原子具有显著降低 Mg₂Si 单晶体的抗剪切变形 能力.此外, $C_{12}-C_{44}$ 值还可表征晶体的脆性,当 $C_{12}-C_{44} > 0$ 时晶体为塑性, 当 $C_{12}-C_{44} < 0$ 晶体



图 2 弹性常数 C₁₁, C₁₂, C₄₄和 C随氢原子浓度增加的变 化趋势

Fig. 2. Relationships between C_{11} , C_{12} , C_{44} and C as a function of H atoms content.

为脆性^[17]. 从表 1 可以看出, 当 H 原子浓度达到 7.69 at.% 时, *C*₁₂-*C*₄₄ 值从由负值增加到正值, Mg₂Si 晶体发生了由脆性向塑性的转变.

3.2 多晶体弹性模量

经 (5)—(9) 式计算的剪切模量 ($G_{\rm H}$)、体模量 ($B_{\rm H}$)、弹性模量 (E)、泊松比 (ν)、脆性 ($B_{\rm H}/G_{\rm H}$) 及 硬度 (H) 如表 2 所列.本工作中的 $G_{\rm H}$, $B_{\rm H}$, E和 ν 值分别为 45.3, 52.5, 105.6 GPa 和 0.16, 与其他 学者的理论计算结果^[6,20] 相比,本工作的最大计算 误差分别为 2.21%, 1.73%, 1.42% 和 4.29%, 计算 精度较高;与其他学者试验结果^[21] 相比,本工作中 的 $B_{\rm H}$ 和 E的最大计算误差分别为 12.38% 和 13.63%,与试验结果同样十分接近,说明本文计算 方法具有较高的可靠性.

图 3 给出了剪切模量 (G_H)、体模量 (B_H)、弹 性模量 (E)、泊松比 (ν) 、脆性 $(B_{\rm H}/G_{\rm H})$ 及硬度 (H) 随氢原子含量增加的变化趋势. 弹性模量 E 是 表征材料刚度的重要参数, E值越高, 材料刚度越 大. 本工作计算结果表明, 未引入氢原子时, Mg,Si 的弹性模量 E 为 105.6 GPa, 随着体系内 H原子 浓度从 0 增加到 7.69 at.%, 弹性模量 E 逐步降低 到 79.5 GPa, 降低了 24.7%. 切变模量 G 与弹性模 量 E 类似, 随着体系氢原子浓度从 0 增加到 7.69 at.%, 切变模量 G从 45.3 GPa 降低到 31.7 GPa, 降低 了 30%. 体模量 B 则随体系氢浓度的改变未表现 出明显的变化. 弹性模量 E 和切变模量 G 的大幅 度降低, 表明 Mg₂Si-H 体系内氢原子浓度的增加, 显著降低了材料的强度、硬度. 与 α-Ti 相似^[25], Mg_oSi 也表现出 H 致软化现象. 硬度计算结果显 示,体系的硬度从不含 H 原子时的 10.31 GPa 逐 步降低到 7.69 at.% H浓度时的 4.55 GPa, 降低 了 55.8%, 印证了弹性模量 E 和切变模量 G 的计 算结果. 随着 H 原子浓度增加, 体系硬度降低, B/G 值逐步增加, 泊松比ν也逐步增大. 当H 原子 浓度达到 7.69 at.% 时, 体系的泊松 v为 0.28, 与 普通低合金钢基本相当^[26]. 说明当大量 H 原子溶 于 Mg₂Si 时, Mg₂Si 将逐步失去其本身具有的高强 度、高硬度和高脆性,可能严重降低以 Mg₂Si 为增 强相材料的强度.

3.3 拉伸性能

图 4 给出了 1 × 1 × 2 的 Mg₂Si 超晶胞和

Phase	Source	Modulus							
		$G_{\rm H}/{ m GPa}$	$B_{\rm H}/{ m GPa}$	$E/{ m GPa}$	ν	$B_{ m H}/G_{ m H}$	$H/{ m GPa}$		
	This work	45.3	52.5	105.6	0.16	1.16	10.31		
Me C:	Calculated [20]	46.2	52.5	107.1	0.16				
Mg_2S1	Calculated [6]	44.3	53.4	104.1	0.17	_	_		
	Experimental $[21]$		59.0	120.0	—				
$\mathrm{Mg_2Si}\text{-}2.05 \mathrm{~at.\%H}$	This work	40.2	53.4	96.5	0.17	1.32	9.07		
Mg_2Si-4 at.%H	This work	39.2	53.7	94.7	0.18	1.37	8.56		
$\mathrm{Mg_2Si}\text{-}7.69 \mathrm{~at.\%H}$	This work	31.7	53.8	79.5	0.28	1.69	4.55		

表 2 Mg₂Si-H 体系模量 Table 2. Modulus of Mg₂Si-H system.



图 3 剪切模量 $(G_{\rm H})$ 、体模量 $(B_{\rm H})$ 、弾性模量 (E)、泊松比 (ν) 、脆性 $(B_{\rm H}/G_{\rm H})$ 及硬度 (H) 与体系 H 原子浓度的变化关系 Fig. 3. Shear moduli *G*, bulk moduli *B*, Young's moduli *E*, Poisson ratios ν , brittleness $B_{\rm H}/G_{\rm H}$ and Hardness *H* as a function of H atoms content.



图 4 Mg₂Si 1 × 1 × 2 超晶胞和 4 at.% Mg₂Si-H 超晶胞 沿 [001] 方向进行拉伸的应力-应变曲线

Fig. 4. Stress vs. strain curves of $1 \times 1 \times 2$ super cell with 4 at.% and without H during stretching along [001] direction.

1 × 1 × 2 的 Mg₂Si-H(4 at.%) 超晶胞沿 [001] 方 向进行拉伸的应力-应变曲线. 从图中可以看出, 当 Mg₂Si 中掺杂 4 at.% 的 H 原子时, 其抗拉强度 从 15.21 GPa 降低到 14.12 GPa, 延伸率则从 0.3 增加到 0.36, 说明 H 原子的掺杂使 Mg₂Si 的强度 降低, 塑性增大. 此外, 掺杂 4 at.% H 原子的 Mg₂Si 在弹性阶段的曲线斜率明显比不掺杂时要小, 说 明 H 原子的掺杂使 Mg₂Si 的弹性模量降低. 拉伸 过程的应力-应变曲线结果与弹性模量计算结果得 到很好地相互应证.

3.4 态密度分析

为探索 H 原子对 Mg₂Si 力学性能影响微观机 制, 对体系的态密度和分波态密度进行了分析, 如 图 5 所示.图 5(a)为 Mg₂Si 晶体的电子态密度和 分波态密度.由图可见, Mg₂Si 晶体的能带主要密 集分布于费米能级两侧, 具有典型的半导体特性.



图 5 (a) Mg₂Si 和 (b) Mg₂Si-7.69 at.%H 总态密度和分波态密度 Fig. 5. DOS and PDOS of (a) Mg2Si and (b) Mg₂Si-7.69 at.% H.

分波态密度显示, 在-9 — -6 eV 能量范围内, Mg₂Si 的态密度主要由 Mg 的 3s 和 Si 的 3s 态电子贡献, Si的 3p 态电子有少量贡献. 在-5-0 eV 能量范围 内, Mg₂Si 的态密度主要由 Mg 的 3p 和 Si 的 3s 态 电子贡献, Si的 3p 态电子有少量贡献.在 0-20 eV 能量范围内, Mg₂Si 的态密度主要由 Si 的 3p 和 3s 态电子贡献, Mg 的 3p 态电子有少量贡献. 当体 系中引入 7.79 at.% 的 H 原子时, H 原子显著增加 了 Mg 和 Si 原子 S 和 P 态电子的贡献率, 总态密 度明显提高;同时,体系在 0-20 eV 能量范围内 的态密度峰缩减到 0-6 eV 范围内, 变现为体系的 禁带变窄,如图 5(b) 所示.于此同时, H 原子的引 入,还引起了费米能级处态密度的增加,态密度跨 过费米能级区域.因此,H原子的引入使体系具有 了一定的金属性质,从而引起材料强度、硬度的降 低, 韧性增加.

4 结 论

1) Mg₂Si-H体系内H原子浓度从0增加到 7.69 at.%, 剪切模量和弹性模量分别下降 24.7%和31.7%,从而造成体系强度硬度降低,韧 性提高.

2) 态密度分析表明, Mg₂Si 晶体中引入氢原

子,将引起 Mg₂Si 晶体由半导体性质向金属性质的转变,从而造成体系强度、硬度的降低,韧性增加.

参考文献

- Li J G, Tan H Y, Shi Z M, He Q 2008 *Chin. J. Nonferrous. Met.* 18 1819 (in Chinese) [李建国, 谭红艳, 史子木, 何迁 2008 中国有色金属学报 18 1819]
- [2] Zeng F L, Wei Z L, Li J F, Li C X, Tan X, Zhang Z, Zheng Z Q 2011 T. Nonferr. Metal. Soc. 21 2559
- [3] Qin Q D, Li W X, Zhao K W, Qiu S L, Zhao Y G 2010 Mat. Sci. Eng. A 527 2253
- [4] Tong X, Zhang D, Wang K, Lin J, Liu Y, Shi Z, Li Y, Lin J, Wen C 2018 Mat. Sci. Eng. A 733 9
- [5] Ren Y Y, Liu T Y, Li Y M 2016 Sci. Sin.: Phys. Mech. Astron. 46 084611 (in Chinese) [任玉艳, 刘桐宇, 李英民 2016 中国科学: 物理学 力学 天文学 46 084611]
- [6] Yu B H, Liu M L, Chen D 2011 Acta Phys. Sin. 60 087105 (in Chinese) [余本海, 刘墨林, 陈东 2011 物理学报 60 087105]
- [7] Han S L, Wang Q, Sun L D, Zhang H X 2008 Chin. J. Nonferrous. Met. 18 523 (in Chinese) [韩秀丽, 王清, 孙东立, 张红星 2008 中国有色金属学报 18 523]
- [8] Zhang F C, Li C F, Wen P, Rang Z L 2014 Acta Phys. Sin.
 66 227101 (in Chinese) [张凤春, 李春福, 文平, 罗强, 冉曾令 2014 物理学报 66 227101]
- [9] Ma G M, Kang S J, Zhang H L, Xu H B 2015 Hot Working Technology 44 96 (in Chinese) [马明光, 亢世江, 张红玲, 徐红 彬 2015 热加工工艺 44 96]
- [10] Yao B D, Hu G Q, Yu Z S 2016 Acta Phys. Sin. 65 026202
 (in Chinese) [姚宝殿, 胡桂青, 于治水 2016 物理学报 65 026202]
- [11] Han X L 2010 Ph. D. Dissertation (Harbin: Harbin Institute of Technology) (in Chinese) [韩秀丽 2010 博士学位论文 (哈尔 滨:哈尔滨工业大学)]

- [12] Rao J P, Ouyang C Y, Lei M S 2012 Acta Phys. Sin. 61 047105 (in Chinese) [饶建平, 欧阳楚英, 雷敏生 2012 物理学 报 61 047105]
- [13] Shi Y, Bai Y, Mo L B, Xiang Q Y, Huang Y L, Cao J L 2015 Acta Phys. Sin. 64 116301 (in Chinese) [石瑜, 白洋, 莫丽玢, 向青云, 黄亚丽, 曹江利 2015 物理学报 64 116301]
- [14] Liu N N, Sun H Y, Liu H S 2009 Mat. Rev. 23 278 (in Chinese) [刘娜娜, 孙翰英, 刘洪生 2009 材料导报: 纳米与新材 料专辑 23 278]
- [15] Li L Y, Yu W, Jin C Q 2005 J. Phys.: Condens. Mat. 17 5965
- [16] Hill R 2002 Proc. Phys. Soc. 65 349
- [17] Jang S H, Chichibu S F 2012 J. Appl. Phys. 112 073503

- [18] Yu W Y, Wang N, Xiao X B 2009 Solid State Sci. 11 1400
- [19] Li Y, Gao Y, Xiao B 2010 J. Alloy Compd. 502 28
- [20] Bystricky J, LaFrance P, Lehar F, Perrot F, Winternitz P 1985 Phys. Rev. D 32 575
- [21] Parks G S 1973 J. Chem. Educ. 30 82A
- [22] Sung C M, Sung M 1996 Mater. Chem. Phys. 43 1
- [23] Leger J M, Djemia P, Ganot F 2001 Appl. Phys. Lett. 79 2169
- [24] Miao N, Sa B, Zhou J 2011 Comp. Mater. Sci. 50 1559
- [25] Senkov O N, Dubois M, Jonas J J 1996 Metall. Mater. Trans. A 27 3963
- [26] Maziyar A, Ahad M, Herbert D, Christian G M 2015 Metall. Mater. Trans. B 46 1471

Effect of H on elastic properties of Mg₂Si by the first principles calculation^{*}

Fu Zheng-Hong Li Ting Shan Mei-Le Guo Kang Gou Guo-Qing[†]

(Key Laboratory of Advanced Technologies of Materials, Ministry of Education, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China) (Received 4 March 2019; revised manuscript received 15 June 2019)

Abstract

The mechanical properties of Al-Mg-Si-type aluminum alloys may degenerate due to the hydrogen damage during servicing in hydrogen environment. The Mg₂Si is the main strengthening phases in Al-Mg-Si-type aluminum alloys. Therefore, the mechanical properties of Mg₂Si directly determine the strengths of Al-Mg-Sitype aluminum alloys. In this work, the effects of hydrogen atoms on the mechanical properties of Mg₂Si are investigated by first principle calculation, which is based on the density function theory. First of all, we calculate the single crystal elasticity constants of C_{11} , C_{12} and C_{44} . Then the elasticity modulus, Poisson's ratio and hardness of polycrystalline are calculated by using the crystal elasticity constants. Furthermore, we also calculate the tensile properties of Mg₂Si with and without H atoms. The difference between the densities of states with and without H atoms is used to investigate the change of Mg₂Si induced by H atoms. The results show that hydrogen atoms significantly reduce the shear modulus and elastic modulus of Mg₂Si, resulting in the strength and hardness decreasing, but the toughness increasing. The calculations of tensile properties indicate that H atoms reduce the fracture strength but enhance the fracture elongation of Mg₂Si to transform from semiconductor to metal properties. The calculated results in this paper can provide a reference basis for revealing the mechanism of strength reduction of Mg₂Si materials in a hydrogen environment.

Keywords: the first principles, Mg_2Si , elastic properties, density of states

PACS: 71.20.-b, 71.22.+i, 43.35.Cg, 31.15.E-

DOI: 10.7498/aps.68.20190368

^{*} Project supported by the Doctoral Innovation Fund Program of Southwest Jiaotong University, China (Grant No. D-CX201831) and the National Key Research and Development Program of China (Grant No. 2016YFB1200602-16).

[†] Corresponding author. E-mail: gouguoqing1001@163.com